(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-110150 (P2003-110150A)

(43)公開日 平成15年4月11日(2003.4.11)

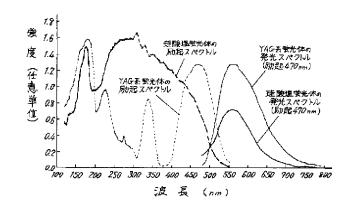
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ					テーマコート	*(参考)
H01L	33/00			H0	1 L	33/00		N	4 H	001
								C	5 F	$0\ 4\ 1$
C09K	11/08			C 0	9 K	11/08		J		
	11/59	СРМ				11/59		CPM		
		CPR						CPR		
			審査請求	未請求	請习	は項の数6	OL	(全 12 頁	() 最	終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-305031(P200	1-305031)	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式			株式会社			
(22)出願日		平成13年10月1日(2001.10.1)		(50)	- A A 1414 .			大字門真10	06番地	
				(72)	発明	大阪府		大字門真10 内	06番地	松下電器
				(72)発明者 大塩 祥三 大阪府門真市大字門真1006 産業株式会社内			06番地	6番地 松下電器		
				(74)	代理。			文雄 (外2名)	
									最	終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体発光素子とこれを用いた発光装置

(57)【要約】

【課題】 近紫外LEDと蛍光体層とを組み合わせてなる、高光束の白色系光を放つ半導体発光素子および半導体発光装置を提供する。

【解決手段】 近紫外LEDと、この近紫外LEDが放つ350~410 nm付近の近紫外光を吸収して400 nm以上500 nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系蛍光体と550 nm以上600 nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせることにより、高光東の白色系光を放つ半導体発光素子を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 350nmを超え410nm以下の波長領域に発光ピークを有する発光を放つ近紫外発光ダイオードと、前記近紫外発光ダイオードが放つ近紫外光を吸収して、380nm以上780nm以下の可視波長領域に発光ピークを有する蛍光を放つ複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせ、CIE色度図における発光色度点(x,y)が、0.21≦x≦0.48、0.19≦y≦0.45の範囲にある白色系光を放つ半導体発光素子であって、前記蛍光体層が、波長380nmおよびその付近の波長領域の近紫外光照射の下で、550nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体と400nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体の二種類の蛍光体を含むことを特徴とする半導体発光素子。

1

【請求項2】 前記黄色系蛍光体が、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体である請求項1記載の半導体発光素子。

(Sr_{1-a1-b1-x}Ba_{a1}Ca_{b1}Eu_x)₂SiO₄ ただし、a1、b1、xは、各々、0≤a1≤0.3、 0≤b1≤0.8、0<x<1を満足する数値である。

【請求項3】 前記珪酸塩蛍光体が、斜方晶の結晶構造を有し下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる 珪酸塩蛍光体である請求項2記載の半導体発光素子。

 $(Sr_{1-a_1-b_2-x}Ba_{a_1}Ca_{b_2}Eu_x)_2SiO_4$

ただし、a1、b2、xは、各々、 $0 \le a1 \le 0$.3、 $0 \le b2 \le 0$.6、0 < x < 1を満足する数値である。

【請求項4】 前記青色系蛍光体が、下記の(1)または(2)のいずれかの青色系蛍光体である請求項1~3 30のいずれかに記載の半導体発光素子。

(1)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる ハロ燐酸塩蛍光体

 $(M1_{1-x}Eu_x)_{10} (PO_4)_6C1_2$

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca、Mgから選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、xは、0 < x < 1 を満足する数値である。

(2) 下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる アルミン酸塩蛍光体

 $(M2_{1-x}Eu_x)$ $(M3_{1-y}1Mn_{y}1)$ $A1_{10}O_{17}$ ただし、M2は、Ba、Sr、Caから選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、<math>M3は、Mg、Znから選ばれる少なくとも一つの元素、x、y1は、各々、0 < x < 1、 $0 \le y1 < 0$. 05を満足する数値である。

【請求項5】 前記近紫外発光ダイオードが、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有する近紫外発光ダイオードである請求項1~4のいずれかに記載の半導体発光素子。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の半導体 50 ている。

発光素子を用いて構成したことを特徴とする半導体発光 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、近紫外発光ダイオード(以後、近紫外LEDという)と複数の蛍光体とを組み合わせて白色系光を放つ半導体発光素子と、この半導体発光素子を用いて構成した半導体発光装置に関するものである。

0 [0002]

【従来の技術】従来から、350nmを超え410nm 以下の近紫外の波長領域に発光ピークを有する近紫外L ED(厳密には近紫外LEDチップ)と、この近紫外L EDが放つ近紫外光を吸収して、380nm以上780 nm以下の可視波長範囲内に発光ピークを有する蛍光を 放つ無機蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせてなる、 白色系光を放つ半導体発光素子が知られている。無機蛍 光体を用いる上記半導体発光素子は、有機蛍光体を用い る半導体発光素子よりも耐久性の面で優れるため、広く 20 用いられている。

【0003】なお、本明細書では、CIE色度図における発光色度点(x, y)が、0.21 $\le x \le 0$.48、0.19 $\le y \le 0$.45の範囲内にある光を白色系光と定義している。

【0004】このような半導体発光素子としては、例えば、特開平11-246857号公報、特開2000-183408号公報、特表2000-509912号公報、特開2001-143869号公報などに開示される半導体発光素子がある。

30 【0005】特開平11-246857号公報には、一般式($La_{1-x-y}Eu_xSm_y$) $_2O_2S$ (ただし、0.0 $1 \le x \le 0.15$ 、0.0001 $\le y \le 0.03$)で表される酸硫化ランタン蛍光体を赤色蛍光体とし、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有し、波長370nm前後の光を放つ近紫外LEDと組み合わせてなる半導体発光素子が記載されている。また、特開平11-246857号公報には、前記赤色蛍光体と、他の青色、緑色蛍光体とを適正に組み合わせることにより、任意の色温度を有する白色光を放つ半導体発光素子に関する発明が開示されている。

【0006】特開2000-183408号公報には、 窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有し、 370nm付近に発光ピークを有する紫外光を放つ紫外 LEDチップと、前記紫外光を吸収して青色光を発光す る青色蛍光体を含む第1の蛍光体層と、前記青色光を吸 収して黄橙色光を発光する黄橙色蛍光体を含む第2の蛍 光体層とを具備する半導体発光素子が記載されている。 ここで青色蛍光体としては、下記の(1)~(3)から 選ばれる少なくとも1種からなる青色蛍光体が用いられ ている。

(1) 一般式 (M1, Eu) 10 (PO4) 6C12 (式 中、M1はMg、Ca、SrおよびBaから選ばれる少 なくとも一つの元素を表す)で実質的に表される2価の ユーロピウム付活ハロ燐酸塩蛍光体。

(2)一般式a(M2, Eu)O·bA12O3(式中、 M2はMg、Ca、Sr、Ba、Zn、Li、Rbおよ びCsから選ばれる少なくとも一つの元素を示し、aお よびbはa>0、b>0、0.2≦a/b≦1.5を満 足する数値である)で実質的に表される2価のユーロピ ウム付活アルミン酸塩蛍光体。

(3) 一般式a (M2, Euv, Mnw) O·bAl₂O₃ (式中、M2はMg、Ca、Sr、Ba、Zn、Li、 RbおよびCsから選ばれる少なくとも一つの元素を示 し、a、b、vおよびwはa>0、b>0、0.2 \leq a /b≦1.5、0.001≦w/v≦0.6を満足する 数値である)で実質的に表される2価のユーロピウムお よびマンガン付活アルミン酸塩蛍光体。

【0007】また、黄橙色蛍光体としては、一般式(Y 1-x-yGdxCey) 3A15O12 (式中、xおよびyは 0.1≤x≤0.55、0.01≤y≤0.4を満足す る数。)で実質的に表される3価のセリウム付活アルミ ン酸塩蛍光体(以後、YAG系蛍光体という)が用いら れている。

【0008】また、特表2000-509912号公報 には、300nm以上370nm以下の波長領域に発光 ピークを有する紫外LEDと、430nm以上490n m以下の波長領域に発光ピークを有する青色蛍光体と、 520 n m以上570 n m以下の波長領域に発光ピーク を有する緑色蛍光体と、590nm以上630nm以下 の波長領域に発光ピークを有する赤色蛍光体とを組み合 30 わせてなる半導体発光素子が開示されている。この半導 体発光素子では、青色蛍光体として、BaMgA110〇 17: Eu, Sr5 (PO4) 3C1: Eu, ZnS: Ag (いずれも発光ピーク波長は450nm)が、緑色蛍光 体として、ZnS:Cu(発光ピーク波長550nm) やBaMgA110O17: Eu, Mn (発光ピーク波長5 15nm)が、赤色蛍光体としては、Y2O2S:Eu3+ (発光ピーク波長628nm)、YVO4:Eu3+(発 光ピーク波長620nm)、Y(V, P, B)O4:E u³⁺ (発光ピーク波長615nm)、YNbO₄:Eu ³⁺ (発光ピーク波長615nm)、YTaO4: E u³⁺ (発光ピーク波長615nm)、[Eu(acac) 3(phen)] (発光ピーク波長611nm)が用い られている。

【0009】一方、特開2001-143869号公報 には、有機材料を発光層とし、430 n m以下の青紫~ 近紫外の波長範囲に発光ピークを有する有機LED、ま たは、無機材料を発光層とし、上記青紫〜近紫外の波長 範囲に発光ピークを有する無機LEDと、青色蛍光体、

4

発光素子が記載されている。この半導体発光素子では、 青色蛍光体としては、Sr₂P₂O₇: Sn⁴⁺、Sr₄A1 14 O 25 : E u 2+ 、B a M g A l 10 O 17 : E u 2+ 、S r G $a_2S_4:Ce^{3+}$ 、 $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$ 、(Ba, S r) $(Mg, Mn) A I_{10}O_{17} : Eu^{2+}, (Sr, C)$ a, Ba, Mg) 10 (PO4) 6C12: Eu2+, BaA 12SiO8: Eu²⁺, Sr₂P₂O₇: Eu²⁺, Sr₅ (P O_4) 3C1: Eu²⁺、(Sr, Ca, Ba) 5 (PO₄) $3C1:Eu^{2+}$, $BaMg_2A1_{16}O_{27}:Eu^{2+}$, (B a, Ca) 5 (PO4) 3C1: Eu²⁺, Ba3MgSi₂ O8: Eu2+、Sr3MgSi2O8: Eu2+が用いられ、 緑色蛍光体としては、(BaMg)A116〇27:E u^{2+} , Mn^{2+} , $Sr_4A1_{14}O_{25}:Eu^{2+}$, (SrB a) A12Si2O8: Eu2+ (BaMg)2SiO4: Eu^{2+} , $Y_2SiO_5: Ce^{3+}$, Tb^{3+} , $Sr_2P_2O_7 =$ $Sr_2B_2O_7: Eu^{2+}$, $(BaCaMg)_5(PO_4)_3C$ $1 : E u^{2+} \setminus S r_2 S i_3 O_8 - 2 S r C 1_2 : E u^{2+} \setminus Z$ $r_2 S i O_4 - MgAl_{11}O_{19} : Ce^{3+}, Tb^{3+}, Ba_2$ $SiO_4:Eu^{2+}$, $Sr_2SiO_4:Eu^{2+}$, (BaS r) SiO4: Eu2+が用いられ、赤色蛍光体として $U_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_4$ $(SiO_4)_6: Eu^{3+}, LiY_9 (SiO_4)_6O_2: Eu$ $^{3+}$, $YVO_4: Eu^{3+}$, $CaS: Eu^{2+}$, $Gd_2O_3: E$ u^{3+} , $Gd_2O_2S:Eu^{3+}$, Y (P, V) $O_4:Eu^{3+}$ が用いられている。

【0010】このように、従来の白色系光を放つ半導体 発光素子では、青色系蛍光体と緑色系蛍光体と赤色系蛍 光体が放つ発光の混色、または、青色系蛍光体と黄色系 蛍光体が放つ発光の混色によって白色系光が得られてい

【0011】なお、青色系蛍光体と黄色系蛍光体が放つ 発光の混色によって白色系光を得る方式の従来の半導体 発光素子では、黄色系蛍光体として、上記YAG系蛍光 体が用いられている。また、上記YAG系蛍光体が、3 50nmを超え410nm以下の波長領域、特に窒化ガ リウム系化合物半導体で構成した発光層を有する近紫外 LEDが放つ360nm以上410nm以下の近紫外光 の励起によってほとんど発光せず、410nm以上53 Onm以下の青色系光の励起下で黄色光を高効率で放つ 蛍光体であるために、YAG系蛍光体を用いた従来の半 導体発光素子では、青色系蛍光体を必須とし、この青色 系蛍光体が放つ青色光によって黄色系蛍光体を励起して 白色系光を得ている。

【0012】このような白色系光を放つ半導体発光素子 は、照明装置や表示装置などの発光装置用として需要の 多い半導体発光素子として知られるものである。

【0013】一方、YAG系蛍光体以外の無機化合物蛍 光体をLEDと組み合わせた半導体発光素子も従来公知 である。前述した特開2001-143869号公報に 緑色蛍光体および赤色蛍光体を組み合わせてなる半導体 50 は、Ba2SiO4:Eu2+、Sr2SiO4:Eu2+、M

g₂SiO₄:Eu²⁺、(BaSr)₂SiO₄:Eu²⁺、 (BaMg)2SiO4:Eu2+珪酸塩蛍光体を用いた半 導体発光素子が記載されている。

【0014】しかしながら、この特開2001-143 869号公報に記載の半導体発光素子では、いずれの珪 酸塩蛍光体も緑色系蛍光体としての応用であり、黄色系 蛍光体としての応用ではない。また、無機化合物からな る無機LEDよりも有機LEDを用いることが発光効率 の点から好ましいともされている。すなわち、この公開 公報に記載の発明は、近紫外LED、好ましくは有機L 10 EDと、青色系、緑色系、赤色系蛍光体の3種類の無機 化合物の蛍光体とを組み合わせてなる半導体発光素子に 関するものである。

【0015】なお、本発明者らの実験の限りでは、この 特開2001-143869号公報に記載されるSr2 SiO4:Eu²⁺ 珪酸塩蛍光体は、二つの結晶相(斜方 晶と単斜晶)を持ち得る蛍光体であり、少なくとも実用 的に用いられるEu2+発光中心添加量(=Eu原子の数 / (Sr原子の数+Eu原子の数):x)が、0.01 ≦x≦0.05の範囲内では、斜方晶Sr₂SiO₄:E u^{2+} ($\alpha' - Sr_2SiO_4: Eu^{2+}$) は、波長560~ 575 n m付近に発光ピークを有する黄色光を放つ黄色 系蛍光体であり、単斜晶 $Sr_2SiO_4:Eu^2+(\beta-S)$ r2SiO4:Eu2+)は、波長545nm付近に発光ピ ークを有する緑色光を放つ緑色系蛍光体である。したが って、特開2001-143869号公報に記載のSr 2 S i O4: E u²⁺緑色蛍光体は、単斜晶 S r₂ S i O4: Eu²⁺蛍光体と見なすことができる。

【0016】ここで、前記珪酸塩蛍光体について説明す ると、従来から、(Sr١-a3-b3-xBaa3Cab3Eux) 2 S i O4の化学式で表される珪酸塩蛍光体(ただし、a 3、b3、xは、各々、 $0 \le a3 \le 1$ 、 $0 \le b3 \le 1$ 、 0 < x < 1を満足する数値)が知られている。上記珪酸 塩蛍光体は、蛍光ランプ用の蛍光体として検討がなされ た蛍光体であり、Ba-Sr-Caの組成を変えること によって、発光のピーク波長が505nm以上598n m以下程度の範囲内で変化する蛍光体であることが知ら れている。さらに、170~350nmの範囲内の光照 射の下で比較的高効率の発光を示す蛍光体であることも 知られている(J. Electrochemical Soc. Vol. 115, No. 11 (1968) p p. 1181-1184参照)。

【0017】しかしながら、上記文献には、上記珪酸塩 蛍光体が、350nmを超える長い波長領域の、近紫外 光励起条件下において高効率の発光を示すことに関する 記載は無い。このため、上記珪酸塩蛍光体が、上記35 0 nmを超え410 nm以下の近紫外の波長領域、とり わけ窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有 する近紫外LEDが放つ370~390 nm付近の近紫 外光励起によって、高効率の、550 n m以上600 n 50 ークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体と400

m未満の黄色系発光を放つ蛍光体であることは、これま で知られていなかった。

【0018】近紫外LEDと複数の蛍光体を含む蛍光体 層とを組み合わせてなる半導体発光素子を用いた従来の 発光装置にあっては、青色系蛍光体と緑色系蛍光体と赤 色系蛍光体が放つ発光の混色、または、青色系蛍光体が 放つ青色系光とこの青色系光を吸収してYAG系蛍光体 が放つ黄色系光の混色によって白色系光を得る方式の半 導体発光素子を用いて発光装置を構成していた。

【0019】なお、本明細書では、半導体発光素子を用 いた各種表示装置(例えばLED情報表示端末、LED 交通信号灯、自動車のLEDストップランプやLED方 向指示灯など)や各種照明装置(LED屋内外照明灯、 車内LED灯、LED非常灯、LED面発光源など)を 広く発光装置と定義している。

[0020]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近紫外LE Dと複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせた、従 来の白色系半導体発光素子にあっては、半導体発光素子 が放つ白色系光の光束が低かった。これは、350 nm を超え410 n m未満の近紫外光励起の下で、高い発光 効率を示す蛍光体の開発がこれまで十分なされていない ために、青色系蛍光体、緑色系蛍光体、赤色系蛍光体の すべてにおいて、白色系半導体発光素子用として使用し 得る蛍光体の種類が少なく、比較的高い発光効率を示す 青色系、緑色系、赤色系の各蛍光体が少数に限定される だけでなく、白色系光の発光スペクトルの形状が限定さ れることに起因する。また、青色系、緑色系、赤色系の 三種類の蛍光体が放つ光の混色、または、青色系蛍光体 が放つ青色系光とこの青色系光を吸収して波長変換され た黄色系光の混色によって白色系光を得ていることにも 起因する。

【0021】本発明は、これらの問題を解決するために なされたものであり、近紫外LEDと蛍光体層とを組み 合わせてなる、高光束の白色系光を放つ半導体発光素子 および半導体発光装置を提供することを目的とする。

[0022]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明の請求項1に係る半導体発光素子は、350 40 nmを超え410nm以下の波長領域に発光ピークを有 する発光を放つ近紫外LEDと、前記近紫外LEDが放 つ近紫外光を吸収して、380nm以上780nm以下 の可視波長領域に発光ピークを有する蛍光を放つ複数の 蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせ、CIE色度図に おける発光色度点(x,y)が、0.21≤x≤0.4 8、0.19≤y≤0.45の範囲にある白色系光を放 つ半導体発光素子であって、前記蛍光体層が、波長38 Onmおよびその付近の波長領域の近紫外光照射の下 で、550nm以上600nm未満の波長領域に発光ピ

nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有す る青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体の二種類の蛍光体を 含むことを特徴とする半導体発光素子である。

【0023】ここで、前記近紫外LEDは、紫外LED を含む250nm以上410nm以下の波長領域に発光 ピークを有する発光を放つLEDであれば特に限定され ないが、入手の容易さ、製造の容易さ、コスト、発光強 度などの観点から、好ましいLEDは300nm以上4 10 n m以下の波長領域に発光ピークを有する発光を放 つ近紫外LED、より好ましくは、350nmを超え4 10 10 n m以下の波長領域に発光ピークを有する発光を放 つ近紫外LED、さらに好ましくは350nmを超え4 00nm未満の波長領域に発光ピークを有する発光を放 つ近紫外LEDである。

【0024】また、前記青色蛍光体は、好ましくは41 0nm以上480nm以下、さらに好ましくは420n m以上460nm以下の波長領域に発光ピークを有する 青色系蛍光体であることが望ましく、また、前記黄色系 蛍光体は、好ましくは570nm以上590nm以下、 さらに好ましくは570nmを超え590nm未満の波 20 長領域に発光ピークを有する黄色系蛍光体であることが 望ましい。

【0025】このような蛍光体層にすると、上記の黄色 系蛍光体と青色系蛍光体の両方が、近紫外LEDが放つ 前記波長領域に発光ピークを有する近紫外光を吸収し、 効率良く、各々黄色系光と青色系光に波長変換するの で、半導体発光素子が、400mm以上500mm未満 の青色系発光と、550nm以上600nm未満の黄色 系発光の、2種類の光色を有する発光を高効率に放つよ うになり、この2種類の光色の混色によって、白色系光 30 を放つようになる。

【0026】また、上記白色系光の演色性を高めるため に、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる酸 硫化物蛍光体などの赤色系蛍光体を配合してもよい。

 $[0027](Ln_{1-x}Eu_x)O_2S$

ただし、Lnは、Sc、Y、La、Gdから選ばれる少 なくとも一つの希土類元素、xは0<x<1を満足する 数値である。

【0028】本発明の請求項2に係る半導体発光素子 は、請求項1の半導体発光素子において、黄色系蛍光体 40 を好ましい態様にしたものであり、黄色系蛍光体を、下 記の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍 光体としたものである。

[0029]

 $(Sr_{1-a_1-b_1-x}Ba_{a_1}Ca_{b_1}Eu_x)_2SiO_4$ ただし、a1、b1、xは、各々、 $0 \le a1 \le 0.3$ 、 $0 \le b 1 \le 0.8$ 、0 < x < 1を満足する数値である。 【0030】ここで、前記化学式におけるa1、b1、 ×の数値は、蛍光体の熱に対する結晶の安定性、耐温度 消光特性、黄色系発光の発光強度、および光色の観点か 50 ただし、M1は、Ba、Sr、Ca、Mgから選ばれる

ら好ましくは、各々、 $0 < a 1 \le 0$. $2 < 0 \le b 1 \le$ $0.7, 0.005 \le x \le 0.1$ 、さらに好ましくは、 各々、0<a1≦0.15、0≦b1≦0.6、0.0 $1 \le x \le 0$. 05を満足する数値であることが望まし

【0031】なお、上記珪酸塩蛍光体は、図4に励起ス ペクトルと発光スペクトルの一例を示すように、250 ~300nm付近に励起ピークを有し、100~500 nmの広い波長範囲内の光を吸収して、550~600 nmの黄緑〜黄〜橙の波長領域に発光ピークを有する黄 色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体である。したがって、上 記珪酸塩蛍光体は、YAG系蛍光体のように、近紫外光 を青色光に変換する青色系蛍光体が無くとも、近紫外L EDが放つ近紫外光を照射すると比較的高効率の黄色系 発光を放つことになるので、近紫外光の黄色系光への変 換効率がYAG系蛍光体よりも実質的に高く、発光効率 の面で好ましいものとなる。

【0032】なお、上記a1とb1が、いずれも0に近 い場合には、斜方晶と単斜晶が混在した珪酸塩蛍光体に なりやすくなり、上記数値範囲よりも大きい場合には結 晶場が弱くなって、いずれの場合でも、緑味を帯びた蛍 光体になって黄色の色純度が悪い発光になる。また、x が上記数値範囲よりも小さい場合には、Eu²+発光中心 濃度が低いために珪酸塩蛍光体の発光強度が弱くなる し、大きい場合には、珪酸塩蛍光体の周囲温度の上昇と ともに発光強度が低下する温度消光の問題が顕著にな

【0033】本発明の請求項3に係る半導体発光素子 は、請求項2の半導体発光素子において、珪酸塩蛍光体 をさらに好ましい態様にしたものであり、珪酸塩蛍光体 を、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなり、 かつ、斜方晶の結晶構造を有する珪酸塩蛍光体としたも のである。

[0034]

 $(Sr_{1-a_1-b_2-x}Ba_{a_1}Ca_{b_2}Eu_x)_2SiO_4$ ただし、a1、b2、xは、各々、0≦a1≦0.3、 $0 \le b \ 2 \le 0.6 \ 0 < x < 1$ を満足する数値であり、 請求項2の場合と同じ観点から、好ましくは、各々、0 <a1 \le 0.2,0 \le b2 \le 0.4,0.005 \le x \le 0.1、さらに好ましくは、各々、0<a1≦0.1 5、0≦b2≦0.3、0.01≦x≦0.05を満足 する数値であることが望ましい。

【0035】本発明の請求項4に係る半導体発光素子 は、請求項1~3のいずれかの半導体発光素子にあっ て、青色系蛍光体を下記の(1)または(2)のいずれ かの青色系蛍光体としたものである。

(1) 下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる ハロ燐酸塩蛍光体

 $(M1_{1-x}Eu_x)_{10} (PO_4)_6C1_2$

a

少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、xは、0<x <1を満足する数値である。

(2)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなるアルミン酸塩蛍光体

 $(M2_{1-x}Eu_x)$ $(M3_{1-y}1Mn_{y}1)$ $A1_{10}O_{17}$ ただし、M2は、Ba、Sr、Caから選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、M3は、Mg、Znから選ばれる少なくとも一つの元素、x、y1は、各々、0 < x < 1、 $0 \le y1 < 0$. 05を満足する数値である。

【0036】上記の青色系蛍光体は、近紫外光の励起によって強い光を放つ高効率蛍光体であるので、このような蛍光体の組み合わせにすると、前記蛍光体層が発光強度の大きな白色系光を放つようになる。

【0037】本発明の請求項5に係る半導体発光素子は、請求項1~4のいずれかの半導体発光素子において、近紫外LEDを、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有する近紫外LEDとしたものである。

【0038】窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発 光層を有する近紫外LEDは、高い発光効率を示し、長 20 期連続動作も可能であるので、このような近紫外LED を用いることにより、長期連続動作が可能で、しかも、 高光束の白色系光を放つ半導体発光素子が得られる。

【0039】本発明の請求項6に係る半導体発光装置は、上記の請求項1~5のいずれかに記載の半導体発光素子を用いて構成した半導体発光装置である。

【0040】本発明の請求項1~5に記載の半導体発光素子は、高光東白色系光を放つので、本発明に係る半導体発光素子を用いて発光装置を構成すると、高光東の白色系光を放つ半導体発光装置が得られる。ここで、半導体発光装置の具体例としては、LED情報表示端末、LED交通信号灯、自動車のLEDストップランプ、LED方向指示灯などの各種表示装置や、LED屋内外照明灯、車内LED灯、LED非常灯、LED面発光源などの各種照明装置を挙げることができる。

【0041】なお、本発明における近紫外LEDに代えて、同じ波長領域に発光ピークを有する発光を主発光成分として放つ発光素子(半導体発光素子に限定されない)を用いても、同様の作用効果が得られ、同様の白色系発光素子が得られることはいうまでもない。

[0042]

【発明の実施の形態】(実施の形態1)以下、本発明の 半導体発光素子の実施の形態を、図面を用いて説明す る。図1~図3はそれぞれ形式の異なる半導体発光素子 の縦断面図である。

【0043】半導体発光素子の代表的な例として、図1に、サブマウント素子5の上にフリップチップ型の近紫外LED1を導通搭載するとともに、青色系蛍光体粒子3と珪酸塩蛍光体の粒子を含む黄色系蛍光体粒子4を内在し蛍光体層2を兼ねる樹脂のパッケージによって、近50

紫外LED1を封止した構造の半導体発光素子を示し、図2に、リードフレーム6のマウント・リードに設けたカップ7に近紫外LED1を導通搭載するとともに、カップ7内に青色系蛍光体粒子3と珪酸塩蛍光体の粒子を含む黄色系蛍光体粒子4を内在した蛍光体層2を設け、全体を封止樹脂8で封止した構造の半導体発光素子を示し、図3に、筐体9内に近紫外LED1を配置するとともに、筐体9内に青色系蛍光体粒子3と珪酸塩蛍光体の粒子を含む黄色系蛍光体粒子4を内在する樹脂で形成した蛍光体層2を設けた構造のチップタイプの半導体発光素子を示している。

1.0

【0044】図1~図3において、近紫外LED1は、350nmを超え410nm以下、好ましくは350nmを超え400nm未満の波長領域に発光ピークを有する近紫外光を得るためのものであり、窒化ガリウム系化合物半導体、炭化シリコン系化合物半導体、セレン化亜鉛系化合物半導体、硫化亜鉛系化合物半導体などの無機化合物や、有機化合物で構成した発光層を有する光電変換素子(いわゆる、LED、無機エレクトロルミネッセンス(EL)素子、有機EL素子)である。

【0045】ここで、大きな近紫外光出力を長期間安定して得るためには、近紫外LED1は無機化合物で構成した無機LEDが好ましく、その中でも、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有する近紫外LEDが、発光強度が大きいのでより好ましい。

【0046】蛍光体層2は、近紫外LED1が放つ近紫 外光を吸収して、CIE色度図における発光色度点

(x, y)が、 $0.21 \le x \le 0.48$ 、 $0.19 \le y \le 0.45$ の範囲にある白色系光に変換するためのものであり、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して400 n m以上500 n m未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体粒子3と、近紫外LED1が放つ近紫外光、とりわけ波長380 n m付近の近紫外光を吸収して550 n m以上600 n m未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体粒子4を含む。

【0047】本発明の半導体発光素子にあっては、蛍光体層2は、青色系蛍光体粒子3と黄色系蛍光体粒子4を含む蛍光体を母材中に分散させて形成する。母材としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ボリイミド樹脂、ユリア樹脂、シリコン樹脂などの樹脂を用いることができ、入手と取り扱いが容易でしかも安価な点でエポキシ樹脂またはシリコン樹脂が好ましい。蛍光体層2の実質厚みは、10μm以上1mm以下、好ましくは100μm以上700μm以上である。

【0048】蛍光体層2中の青色系蛍光体粒子3は、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して、400nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ蛍光体であれば、無機材料であっても有機材料(例えば蛍光色素)であっても使用することがで

きるが、望ましくは、下記の(1)または(2)のいず れかの蛍光体とするのがよい。

(1)以下の化学式で表される化合物を主体にしてなる ハロ燐酸塩蛍光体

 $(M1_{1-x}Eu_x)_{10} (PO_4)_6C1_2$

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca、Mgから選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、xは、0 < x < 1 を満足する数値である。

(2)以下の化学式で表される化合物を主体にしてなる アルミン酸塩蛍光体

 $(M2_{1-x}Eu_x)$ $(M3_{1-y}IMn_{y}I)$ $A1_{10}O_{17}$ ただし、M2は、Ba、Sr、Caから選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、M3は、Mg、Znから選ばれる少なくとも一つの元素、x、y1は、各々、0 < x < 1、 $0 \le y1 < 0$. 05を満足する数値である。

【0049】なお、上記望ましい青色系蛍光体の具体例としては、 $BaMgAl_{10}O_{17}:Eu^{2+}$ 、(Ba,Sr) (Mg,Mn) $Al_{10}O_{17}:Eu^{2+}$ 、(Sr,Ca,Ba) Ba,Mg) Ba,Mg ($Cl_{2}:Eu^{2+}$) ($Cl_{2}:$

【0050】蛍光体層2中の黄色系蛍光体粒子4としては、製造の容易さや発光性能の良好さ(高輝度、高黄色純度)の点から、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体が望ましい。

[0051]

 $(Sr_{1-a1-b1-x}Ba_{a1}Ca_{b1}Eu_x)_2SiO_4$ ただし、a1、b1、xは、各々、 $0 \le a1 \le 0$. 3、 $0 \le b1 \le 0$. 8、0 < x < 1を満足する数値、好ましくは、 $0 < a1 \le 0$. 2、 $0 \le b1 \le 0$. 7、0. 00 $5 \le x \le 0$. 1、さらに好ましくは、 $0 < a1 \le 0$. 1 5、 $0 \le b1 \le 0$. 6、0. $01 \le x \le 0$. 05である。

【0052】このような黄色系蛍光体としては、下記の(1)または(2)に記載のいずれかの珪酸塩蛍光体がある。

(1)斜方晶の結晶構造を有する、下記の組成の珪酸塩 蛍光体

 $(Sr_{1-a1-b2-x}Ba_{a1}Ca_{b2}Eu_x)_2SiO_4$ ただし、a1、b2、xは、各々、 $0 \le a1 \le 0$. 3、 $0 \le b2 \le 0$. 6、0 < x < 1、好ましくは、各々、 $0 < a1 \le 0$. 2、 $0 \le b2 \le 0$. 4、0. $005 \le x \le 0$. 1、さらに好ましくは、各々、 $0 < a1 \le 0$. 1 5、 $0 \le b2 \le 0$. 3、0. $01 \le x \le 0$. $05 \ge 3$ $05 \ge 3$

(2)単斜晶の結晶構造を有する、下記の組成の珪酸塩 蛍光体 $(Sr_{1-a2-b1-x}Ba_{a2}Ca_{b1}Eu_x)_2SiO_4$ ただし、a2、b1、xは、各々、 $0 \le a2 \le 0$. 2、 $0 \le b1 \le 0$. 8、0 < x < 1、好ましくは、各々、 $0 \le a2 \le 0$. 15、 $0 < b1 \le 0$. 7、0. $005 \le x \le 0$. 1、さらに好ましくは、各々、 $0 \le a2 \le 0$. 1、 $0 < b1 \le 0$. 6、0. $01 \le x \le 0$. $05e^{-a2}$ する数値である。

12

【0053】a1、a2、b1、b2の数値が上記範囲内よりも小さい数値の組成では、珪酸塩蛍光体の結晶構造が不安定になりやすく、動作温度によって発光特性が変化する問題が生じる。一方、上記範囲内よりも大きい数値の組成では、発光が緑味を帯びたものとなり、良好な黄色系蛍光体にはならず、緑色系蛍光体となるために、青系の蛍光体と組み合わせても、高光束、白色系光を放つ半導体発光素子にはならない。また、Eu添加量xが上記範囲内よりも小さい数値の組成では発光強度が弱く、大きい数値の組成では、周囲温度の上昇とともに発光強度が低下する温度消光の問題が顕著に生じる。

【0054】本発明の半導体発光素子において用いる黄 20 色系蛍光体としては、珪酸塩蛍光体が放つ黄色系光の色 純度が優れる理由で、上記斜方晶の結晶構造を有する珪 酸塩蛍光体を用いるのが好ましい。また、珪酸塩蛍光体 の結晶構造を安定化したり、発光強度を高める目的で、 Sr、Ba、Caの一部をMgやZnで置き換えること もできる。

【0055】さらに、珪酸塩蛍光体の発光色を制御する目的で、Siの一部をGeで置き換えることもできる。すなわち、黄色系蛍光体として下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体を用いることがで30 きる。

[0056] ($Sr_{1-a1-b1-x}Ba_{a1}Ca_{b1}Eu_x$) 2 ($Si_{1-z}Ge_z$) O₄

ただし、a1、b1、x、zは、各々、 $0 \le a1 \le 0$. 3、 $0 \le b1 \le 0$. 8、0 < x < 1、 $0 \le z < 1$ を満足する数値である。

【0057】上記珪酸塩蛍光体は、レーザー回折・散乱式粒度分布測定器(例えばLMS-30:株式会社セイシン企業製)による粒度分布評価で、中心粒径が0.1 μ m以上100 μ m以下のものであれば足りるが、蛍光体の合成の容易さ、入手の容易さ、蛍光体層の形成の容易さなどの理由で、中心粒径が1 μ m以上20 μ m以下が好ましく、2 μ m以上10 μ m以下がさらに好ましい。粒度分布については、0.01 μ m未満および100 μ mを超える粒子を含まなければよいが、中心粒径と同じ理由で、1 μ m以上50 μ m以下の範囲内で正規分布に近似した分布を有する珪酸塩蛍光体は、例えば、前記文献(J.Electrochemical Soc. Vol. 115、No. 11(1968) pp. 1

50 181-1184) に記載の合成方法によって製造する

ことができる。

【0059】以下、上記珪酸塩蛍光体の特性をさらに具体的に説明する。

【0060】図4は、上記珪酸塩蛍光体の励起スペクトルおよび発光スペクトルの例を示す図である。同図には比較のために、従来のYAG系蛍光体の励起スペクトルおよび発光スペクトルの例もまとめて示している。

【0061】図4からわかるように、YAG系蛍光体が 100nm~300nm付近、300nm~360nm 付近、400mm~550mm付近の三カ所に励起帯を 有し、これら各々の狭い波長範囲内の光を吸収して、5 50~580nmの黄緑~黄の波長領域に発光ピークを 有する黄色系の蛍光を放つ蛍光体であるのに対して、本 発明において使用する珪酸塩蛍光体は、250~300 nm付近に励起ピークを有し、100~500nmの広 い波長範囲内の光を吸収して、550~600nmの黄 緑〜黄〜橙の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍 光を放つ黄色系蛍光体である。また、350nmを超え 400 n m未満の近紫外光の励起下では、YAG系蛍光 体をはるかに凌ぐ高効率の蛍光体であることもわかる。 特に、波長領域が370~390nmの近紫外光の励起 下では、従来のYAG系蛍光体が実質的に発光しないの に対して、珪酸塩蛍光体は高効率の黄色系光を放つこと

【0062】したがって、上記珪酸塩蛍光体を黄色系蛍 光体粒子4として蛍光体層2に含めることによって、蛍 光体層2が近紫外光の励起下で強い黄色系光を発光成分 として放つようになる。

【0063】なお、上記したa1、a2、b1、b2、x、zの数値範囲内の組成の珪酸塩蛍光体であれば、励 30 起および発光スペクトルは、図4に例示した珪酸塩蛍光体のスペクトルに類似したものとなる。

【0064】また、上記の青色系蛍光体粒子3と黄色系 蛍光体粒子4のほかに、白色系光の演色性を高めるため に、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる酸 硫化物蛍光体などの赤色系蛍光体粒子を配合してもよ い。

 $[0065](Ln_{1-x}Eu_x)O_2S$

ただし、Lnは、Sc、Y、La、Gdから選ばれる少なくとも一つの希土類元素、xは0<x<1を満足する数値である。

【0066】(実施の形態2)以下、本発明の半導体発 光装置の実施の形態を図面を用いて説明する。図5〜図 7は本発明に係る半導体発光装置の例を示す図である。

【0067】図5は本発明の半導体発光素子を用いたスタンド型の照明装置を示し、図6は本発明の半導体発光素子を用いた画像表示用の表示装置を示し、図7は本発明の半導体発光素子を用いた数字表示用の表示装置を示している。

【0068】図5ないし図7において、半導体発光素子 50 部要因による発光素子の特性変動もほぼ同一にできるよ

14 10は実施の形態1で説明した本発明の半導体発光素子である

【0069】図5において、11は半導体発光素子10を点灯させるためのスイッチであり、スイッチ11を0 Nすると、半導体発光素子10が通電して発光を放つようになる。

【0070】なお、図5の照明装置は好ましい一例として示したもので、本発明に係る半導体発光装置はこの実施形態に限定されるものではなく、本発明の半導体発光素子10のほかに例えば、青、緑、黄、赤などの光を放つLEDと組み合わせたものであってもよい。また、半導体発光素子10の発光色、大きさ、数、発光部分の形状なども特に限定されるものではない。

【0071】また、この例の照明装置において、好ましい色温度は2000K以上12000K以下、好ましくは3000K以上10000K以下、さらに好ましくは3500K以上8000K以下であるが、本発明に係る半導体発光装置としての照明装置は前記色温度に限定されるものではない。

【0072】図6と図7には、本発明に係る半導体発光 装置としての表示装置の例として画像表示装置と数字表 示装置を示したが、本発明に係る半導体発光装置はこれ らに限定されるものではない。

【0073】半導体発光装置の一例としての表示装置は、上記照明装置の場合と同様に、実施の形態1で説明した半導体発光素子10を用いて構成しておればよく、また、半導体発光素子10以外の半導体発光素子、例えば、青、緑、黄、赤などの光を放つLEDと組み合わせていてもよい。また、半導体発光素子10の発光色、大きさ、数、発光部分の形状や半導体発光素子の配置の仕方なども特に限定されるものではないし、外観形状も特に限定されるものではない。

【0074】画像表示装置としての寸法は幅1cm以上10m以下、高さ1cm以上10m以下、奥行き5mm以上5m以下の範囲で任意に製作することができ、この寸法に応じて半導体発光素子の個数を設定することができる。

【0075】図6に示す数字表示装置において、10が 実施の形態1で説明した半導体発光素子である。この数 字表示装置においても、画像表示装置の場合と同様に、 半導体発光素子10の発光色、大きさ、数、画素の形状 などは限定されるものではない。また、表示文字は数字 に限定されるものではなく、漢字、カタカナ、アルファ ベット、ギリシア文字などであっても構わない。

【0076】なお、図5~図7に示したような半導体発 光装置にあっては、一種類のLEDチップだけを用いた 複数個の半導体発光素子10を用いて構成した発光装置 にすると、全く同じ駆動電圧や注入電流での各半導体発 光素子の動作が可能になるとともに、周囲温度などの外 部裏因による発光素子の特性変動なほぼ同一にできるよ

うになり、電圧変化や温度変化に対する発光素子の発光 強度や色調の変化率を少なくできるとともに、発光装置 の回路構成をシンプルにできる。

【0077】また、画素面が平坦な半導体発光素子を用いて半導体発光装置を構成すると、表示面が平坦な表示装置や面発光する照明装置など、発光面の平坦な発光装置を提供でき、良好な画質を有する画像表示装置や、デザイン性に優れる照明装置を提供できる。

【0078】本発明に係る半導体発光装置は、実施の形態1に記載した、高光束の白色系光が得られる半導体発 10 光素子を用いて発光装置を構成することによって、高光 束の発光装置となる。

[0079]

【実施例】(実施例1)青色系蛍光体を(M21-x E u_x) (M3_{1-y1}Mn_{y1}) A1₁₀O₁₇ (ただし、M2 は、Ba、Sr、Caから選ばれる少なくとも一つのア ルカリ土類金属元素、M3は、Mg、Znから選ばれる 少なくとも一つの元素、x、y1は、各々、0<x< 1、0≤y1<0.05を満足する数値である。)の化 学式で表される、(Ba, Sr) MgA 110 O17: Eu 2+, M n 2+ アルミン酸塩青色蛍光体 (M 2 = 0.9 B a +0.1Sr、x=0.1、y=0.015)とし、黄 色系蛍光体を(Sr1-a1-b1-xBaa1Cab1Eux)2S i O₄ (ただし、a 1、b 1、x は、各々、0 ≦ a 1 ≦ 0.3、0≤b1≤0.8、0<x<1を満足する数値 である。) の化学式で表され、斜方晶の結晶構造を有す る、(Sr, Ba)2SiO4:Eu2+珪酸塩黄色蛍光体 (a1=0.1, b1=0, x=0.02) とし、この 青色蛍光体と黄色蛍光体の混合重量割合を35:15、 エポキシ樹脂と混合蛍光体との重量割合を120:5 ○、蛍光体層の実質厚みを約600μmとして半導体発 光素子(実施例1)を製作した。

【0080】半導体発光素子の構造は、図2に示したような、マウント・リードに設けたカップに近紫外LED*

*を導通搭載するとともに、カップ内に蛍光体粒子が内在するエポキシ樹脂で形成した蛍光体層を設けた構造の半導体発光素子とした。また、近紫外LEDは、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有し、波長380nmに発光ピークを有する、InGaN系の近紫外LEDとした。

16

【0081】この近紫外LEDからの波長380nmの 近紫外光励起下での、青色系蛍光体の発光スペクトルを 図8の(a)に、黄色蛍光体の発光スペクトルを同図の (b)に示した。

【0082】比較のために、前記(Ba, Sr)MgA 110 O17: Eu²+, Mn²+アルミン酸塩青色蛍光体を青色系蛍光体、BaMgA110 O17: Eu²+、Mn²+(Ba0.9 Eu0.1 Mg0.7 Mn0.3 A110 O17) アルミン酸塩緑色蛍光体を緑色系蛍光体、LaO₂S: Eu³+(La0.9 Eu0.1 O2S) 酸硫化物赤色蛍光体を赤色系蛍光体とし、蛍光体層中に黄色系蛍光体を含まない、上記と同様の半導体発光素子(比較例1)を製作した。比較例1の半導体発光素子でのアルミン酸塩青色蛍光体、アルミン酸塩緑色蛍光体、酸硫化物赤色蛍光体の混合重量割合は7:13:40であり、エポキシ樹脂と混合蛍光体との重量割合と蛍光体層の実質厚みは実施例1の半導体発光素子と同じである。

【0083】上記半導体発光素子の近紫外LEDに10 mAを通電して、近紫外LEDを動作させ、半導体発光素子からの白色系光のCIE色度図における(x,y)値、光束の相対値を、瞬間マルチ測光システム(MCPD-7000:大塚電子株式会社製)を用いて評価した。この結果を表1に示す。表1からわかるように、ほぼ同じ色度の白色系光のもとでは、本発明にかかる半導体発光素子(実施例1)の方が、高い光束(約3.7倍)が得られた。

[0084]

【表1】

	х	У	光束の相対値
実施例1	0.300	0.298	6413
比較例 1	0.313	0.300	1744

[0085]

【発明の効果】本発明の半導体発光素子は、近紫外LEDと、この近紫外LEDが放つ350~410nm付近の近紫外光を吸収して400nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系蛍光体と、前記近紫外光を吸収して550nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせたことにより、高光束の白色系光を放つ半導体発光素子を得ることができる。特に黄色系蛍光体として珪酸塩蛍光体を用いることにより、YAG系蛍光体を用いた従来の半導体発光素子をはるかに凌ぐ高効率の半導体発光素子となる。

※【0086】また、本発明の発光装置は、近紫外光励起 40 の下で効率良く発光する青色系蛍光体と黄色系蛍光体の 2種類の蛍光体を含む蛍光体層を有し、高光束の前記半 導体発光素子を用いて発光装置を構成することにより、 高光束の白色系光を放つ発光装置とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態である半導体発光素子の縦断 面図

【図2】本発明の実施形態である半導体発光素子の縦断 面図

【図3】本発明の実施形態である半導体発光素子の縦断 ※50 面図 【図4】珪酸塩蛍光体とYAG系蛍光体の発光および励起スペクトルの例を示す図

【図5】本発明の実施形態である発光装置の斜視図

【図6】本発明の実施形態である発光装置の斜視図

【図7】本発明の実施形態である発光装置の斜視図

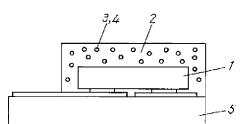
【図8】(a)は、青色系蛍光体の発光スペクトルを示す図

(b)は、黄色系蛍光体の発光スペクトルを示す図 【符号の説明】

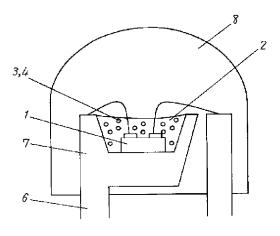
1 近紫外LED

- 2 蛍光体層
- 3 青色系蛍光体粒子
- 4 黄色系蛍光体粒子
- 5 サブマウント素子
- 6 リードフレーム
- 7 カップ
- 8 封止樹脂
- 9 筐体
- 10 半導体発光素子
- 10 11 スイッチ

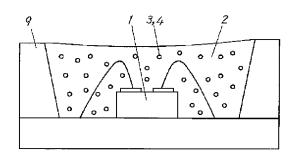




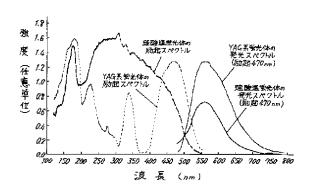
【図2】



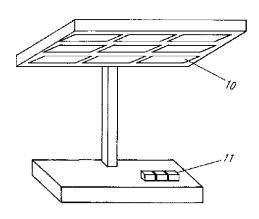
【図3】



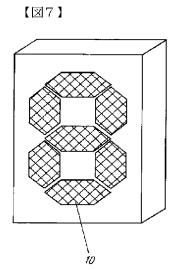
【図4】



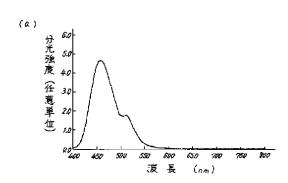
【図5】

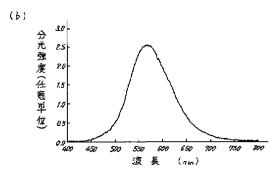


[] 6]



【図8】





フロントページの続き

(51)Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C09K 1	1/59 CPX	C 0 9 K	11/59 CPX	
1	1/64		11/64	
1	1/73		11/73	

(72)発明者 岩間 克昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 北原 博実

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 池田 忠昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

Fターム(参考) 4H001 CA02 CA04 CA05 XA08 XA12

XA14 XA15 XA17 XA20 XA30

XA38 XA56 YA25 YA63

5F041 AA11 CA34 CA40 DA18 DA19

DA44 DA46 EE25